

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成24年7月26日(2012.7.26)

【公開番号】特開2011-222805(P2011-222805A)

【公開日】平成23年11月4日(2011.11.4)

【年通号数】公開・登録公報2011-044

【出願番号】特願2010-91291(P2010-91291)

【国際特許分類】

H 01 L 23/14 (2006.01)

H 01 L 25/07 (2006.01)

H 01 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 01 L 23/14 R

H 01 L 25/04 C

【手続補正書】

【提出日】平成24年6月8日(2012.6.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0016

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0016】

以上説明したように、本実施の形態では、低誘電率膜19が半田16と下面電極15の側面を覆い、低誘電率膜20が半田17と半導体チップ18の側面を覆っている。これにより、半田17からの気泡発生を抑制することができる。よって、絶縁不良を低減することができ、製品の長寿命化が可能となる。